**Thesis Title** Fabrication and Mechanical and Electrical Properties of

Bismuth Sodium Zirconate-based Compounds

**Author** Mr. Panupong Jaiban

**Degree** Doctor of Philosophy (Materials Science)

**Thesis Advisory Committee** 

Asst. Prof. Dr. Anucha Watcharapasorn Advisor

Assoc. Prof. Dr. Sukanda Jiansirisomboon Co-advisor

Dr. Manoch Naksata Co-advisor

## **ABSTRACT**

In this research, a powder and ceramic fabrications of lead-free bismuth sodium zirconate Bi<sub>0.5</sub>Na<sub>0.5</sub>ZrO<sub>3</sub> (BNZ) were investigated. Initially, BNZ powder was prepared using a mixed oxide method. The mixed powder was subsequently calcined at different conditions including the temperature range from 700 to 850°C for 2 h and 800°C for 2, 4, 6 and 8 h with heating/cooling rate 5°C/min. From the results, it was found that calcined BNZ powder consisted of secondary phases of Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and ZrO<sub>2</sub>. In order to approach the single phase of the powder, the effect of adding excess Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> and ZrO<sub>2</sub> was studied. It was found that Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> addition could decrease the secondary non-perovskite phases. As seen in this study, the optimized condition for BNZ powder preparation was BNZ/10wt%Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> composition calcined at 800°C for 2 h. After that, phase characterization and crystal structure determination of the

powder were carried out employing X-ray diffraction technique and Powder Cell software, respectively. The results revealed that BNZ material possessed an orthorhombic perovskite structure. Powder morphologies showed a broad particle size distribution and an energy dispersive X-ray analysis indicated the main elements in the powder were. Bi, Na, Zr and O.

For BNZ ceramics, the samples were fabricated using a conventional solid-state sintering technique at 800-1,100°C for 2 h and at 900°C for 2, 4, 6 and 8 h with heating/cooling rate of 5°C/min. It was observed that BNZ ceramics had a porous microstructure and low relative density. Thus, the influence of the particle characteristics and ball milling time was examined and the study showed that the ball milling time of 72 h produced powder with a narrow size distribution, which in turn decreased the porosity, average grain size and enhanced the densification rate of ceramic. However, the relative density value of the ceramics was still rather low as compared with general ceramics (≥95%). Sintering aids i.e. Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> were therefore added to BNZ ceramics in concentration of 1, 4, 7 and 10 wt% to improve the densification of BNZ. For sample fabrication, Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- and Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-doped pellets were sintered at 800-900°C for 2 h. It was found that the relative density of BNZ/4wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ceramic reached the typical value of the dense ceramics. Hence, the dense ceramic of BNZ compound could be prepared with the optimized condition being BNZ/4wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> sintered milled for 72 h and at 850°C for 2 h.

Phase identification, microstructure and mechanical properties of BNZ ceramics would be discussed together with Ti ion substitution at B-site of Zr ions within the lattice  $Bi_{0.5}Na_{0.5}Zr_{1-x}Ti_xO_3$  (BNZT) where x = 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 0.6 mole fraction. X-ray diffraction data revealed a phase transition region due to Ti addition.

This included a single phase of orthorhombic structure for the compositions  $0 \le x \le 0.2$ , a mixed phase of orthorhombic and rhombohedral structure for  $0.3 \le x \le 0.4$  and a single phase of rhombohedral structure for Ti-rich compositions. Besides, an inhomogeneous area in the samples could be observed by SEM images. According to the mechanical properties, BNZT ceramics showed the values not much different from those of typical ceramics and they did not depend on Ti modification. Thermal expansion results suggested that the Curie temperature of ceramics ranged about 100-150°C and decreased with increasing Ti content.

For dielectric properties at room temperature of BNZT ceramics, it was found that the relative permittivity increased when Ti concentration increased due to the phase transformation from orthorhombic to rhombohedral lattice. As for the dielectric properties as a function of the temperature, the dielectric constant values increased with temperature increment. Moreover, the phase transition temperatures observed from this result were correlated well with that of thermal expansion data. For *P-E* hysteresis loops, the data implied a rather high conductivity of BNZT ceramics. Nevertheless, their dielectric properties at low- and high electric field indicated a single domain response on applied external electric field.

In conclusion, BNZ-based ceramics could be fabricated and dielectric properties were enhanced using Ti addition. BNZT ceramic investigation has brought new knowledge in many aspects of electroceramics. In the near future, this information may be useful for further research and advanced electronic device production.

. ชื่อเรื่องวิทยานิพน<del>ห</del>์

การประดิษฐ์และสมบัติเชิงกลและเชิงไฟฟ้าของ

สารประกอบที่มีบิสมัทโซเคียมเซอร์โคเนตเป็นหลัก

ผู้เขียน นายภาณุพงศ์ ใจบาล

ปริญญา วิทยาศาสตรคุษฎีบัณฑิต (วัสคุศาสตร์)

บางเหมูย มาเกาการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผส. ดร. อนชา วัชระภาสร อาจ

ผศ. คร. อนุชา วัชระภาสร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ. คร. สุกานคา เจียรศิริสมบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

อ. คร. มาโนช นาคสาทา

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

## บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการสังเคราะห์ผง และการเตรียมเซรามิกไร้สารตะกั่วระบบบิสมัทโซเดียม เซอร์โคเนค  ${
m Bi}_{0.5}{
m Na}_{0.5}{
m ZrO}_3$  (BNZ) เริ่มต้นจากการเตรียมผง BNZ โดยใช้เทคนิคการผสม แล้วทำการเผาแคลไซน์ด้วยอัตราขึ้นลงของ ออกไซค์แบบง่ายผ่านกระบวนการบดย่อยละเอียด อุณหภูมิเป็น 5 องศาเซลเซียส/นาที ในสภาวะแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ เผาที่ช่วงอุณหภูมิ 700 – 850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4, 6 และ 8 ชั่วโมง จากผลการศึกษานี้ พบว่า ผง BNZ ยังคงประกอบด้วยเฟสปนเปื้อนของ บิสมัท และ เซอร์โกเนียมออกไซน์ ดังนั้น อิทธิพลปริมาณของสารตั้งต้นที่มากเกินพอ  ${
m Bi}_2{
m O}_3$ ,  ${
m Na}_2{
m CO}_3$  และ  ${
m ZrO_2}$  ที่มีต่อความบริสุทธิ์ของผง BNZ จึงถูกศึกษาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบว่า การเติม  $Na_2CO_3$  ช่วยให้ผง BNZ ปราศจากการปนเปื้อนของเฟส  $Bi_2O_3$  และ  $ZrO_2$ จากการศึกษาดังกล่าว สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์ คือ  $\mathrm{BNZ/10wt}\%\mathrm{Na_2CO_3}$  เผา แคลไซน์ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นตรวจสอบลักษณะเฟส และ โครงสร้างผลึกโดยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์และโปรแกรม Powder Cell พบว่า ผง BNZ มีโครงสร้างผลึกเป็นแบบออโธรอมบิก ผลการตรวจสอบลักษณะสัณฐานด้วยกล้องจุลทรรศน์ และองค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิคการกระจายของรังสีเอกซ์แสดงให้เห็น อิเล็กตรอน กระจายตัวค่อนข้างกว้างของขนาดอนุภาคผง และมีชาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักคือ บิสมัท โซเดียม เซอร์โคเนียม และออกซิเจน

สำหรับการเดรียมเซรามิก BNZ โดยเทคนิกการเผาผนึกแบบดั้งเดิม ที่ช่วงอุณหภูมิ 850-100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4, 6 และ 8 ชั่วโมง ด้วยอัตราขึ้นลงของอุณหภูมิเป็น 5 องศาเซลเซียส/นาที พบว่า โครงสร้างทางจุลภาคของ เซรามิก BNZ ประกอบด้วยรูพรุน และมีความหนาแน่นด่ำ ดังนั้น อิทธิพลลักษณะการกระจายตัว ของขนาดอนุภาคขึ้นอยู่กับเวลาการบดย่อยละเอียด จึงถูกศึกษา และพบว่า ตัวอย่างผง BNZ บด ย่อยละเอียดเป็นเวลา 72 ชั่วโมง มีลักษณะการกระจายตัวของขนาดอนุภาคเริ่มต้นแคบ ทำให้ขนาด รูพรุนของเซรามิกเล็กลง ขนาดเกรนเฉลี่ยลดลง และความหนาแน่นสูงสุด อย่างไรก็ตาม ความ หนาแน่นเซรามิกยังต่ำ เมื่อเทียบกับเซรามิกทั่วไป จากนั้นตัวช่วยในการแน่นตัวเซรามิกระหว่าง การเผาผนึก  $Bi_2O_3$  และ  $Na_2CO_3$  ถูกเพิ่มในเซรามิก BNZ ที่ผ่านการบดละเอียดเป็นเวลา 72 ชั่วโมง ในอัตราส่วนเป็น 1, 4, 7 และ 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เผาที่ช่วงอุณหภูมิ 800-900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบว่าเซรามิก BNZ ที่ถูกเจือด้วย  $Bi_2O_3$  ในปริมาณ 4 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก มีความหน่าแน่นใกล้เกียงกับตัวอย่างเซรามิกทั่วไป คือ ร้อยละ 95 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น การเตรียมเซรามิกของสารประกอบ BNZ สามารถเตรียมได้ที่เงื่อนไข BNZ72/4wt% $Bi_2O_3$  เผาที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

สำหรับลักษณะเฟส โครงสร้างทางจุลภาค และสมบัติเชิงกลของเซรามิก BNZ ในการศึกษานี้ ได้อธิบายเทียบกับการเจือไอออนของไททาเนียม ( $\mathrm{Ti}^{4+}$ ) ณ ตำแหน่ง B ของไอออนของ เซอร์โคเนียม ( $\mathrm{Zr}^{4+}$ ) ภายในโครงโครงสร้าง  $\mathrm{Bi}_{0.5}\mathrm{Na}_{0.5}\mathrm{Zr}_{1-x}\mathrm{Ti}_x\mathrm{O}_3$  (BNZT) เมื่อ x มีค่าเท่ากับ 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 และ 0.6 เสษส่วนโดยโมล รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิก BNZT แสดงให้เห็นช่วงการเปลี่ยนเฟสในช่วงต่างๆ ดังนี้ เฟสเดี่ยวของโครงสร้างออโธรอมบิกที่ อัตราส่วน  $0 \le x \le 0.2$ , เฟสร่วมกันของโครงสร้างออโธรอมบิกและรอมโบฮีดรอลที่อัตราส่วน  $0.3 \le x \le 0.4$  และเฟสเดี่ยวของโครงสร้างรอมโบฮีดรอล  $0.5 \le x \le 0.6$  นอกจากนี้ ความไม่เป็นเนื้อ เดียวกันของเซรามิก BNZT ในบางบริเวณสามารถสังเกตุเห็นด้วยภาพถ่ายโครงสร้างทางจุลภาค จากการศึกษาสมบัติเชิงกล พบว่า เซรามิก BNZT มีค่าสมบัติเชิงกลใกล้เคียงกับเซรามิกทั่วไป และ ไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณการเจือ  $\mathrm{Ti}^4$  การศึกษาการขยายตัวทางความร้อนของเซรามิก BNZT พบว่า อุณหภูมิการเปลี่ยนเฟสจากเฟอโรอิเล็กทริกเป็นพาราอิเล็กทริกของเซรามิก BNZT อยู่ในช่วง 100 ถึง 150 องศาเซลเซียส และมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณการเจือ  $\mathrm{Ti}^{4+}$ 

ผลการศึกษาสมบัติ ไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิห้อง พบว่า ค่าคงที่ ไดอิเล็กทริกเพิ่มขึ้นตาม ปริมาณการเจือ Ti<sup>4+</sup> เนื่องจากการเปลี่ยนเฟสจากออ โชริมบิกเป็นรอม โบฮีดรอล จากการศึกษา สมบัติ ใดอิเล็กทริกเทียบกับอุณหภูมิ พบว่า ค่า ไดอิเล็กทริกและการสูญเสีย ไดอิเล็กทริกเพิ่มขึ้นเมื่อ อุณหภูมิเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ อุณหภูมิการเปลี่ยนเฟสจากเฟอ โรอิเล็กทริกเป็นพาราอิเล็กทริกของ เซรามิก BNZT ที่ ได้จากการวัดสมบัติ ใดอิเล็กทริกสอดคล้องกับช่วงอุณหภูมิที่พบในการศึกษาการ ขยายตัวทางความร้อน เซรามิก BNZT ทุกอัตราส่วน แสดงลักษณะวงวนฮิสเทอรีซีสเป็นวงรี ชี้ให้เห็นสภาพการนำ ไฟฟ้าสูงในชิ้นงาน อย่างไรก็ตาม สมบัติ ไดอิเล็กทริกในสนาม ไฟฟ้าต่ำและ สูง แสดงให้เห็น การตอบสนองของโดเมนเดี่ยวๆ ของเซรามิกต่อสนาม ไฟฟ้าภายนอก

จากงานวิจัยนี้จึงสรุปได้ว่า สามารถผลิตเซรามิกระบบที่มีบิสมัทโซเดียมเซอร์โคเนตเป็นฐาน และสมบัติใดอิเล็กทริกของเซรามิกถูกปรับปรุงด้วยการเจือไอออนของไททาเนียม ดังนั้นการศึกษา เซรามิกในระบบใหม่นี้ถือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นพื้นฐาน และแนวทางในการ ศึกษาวิจัย และพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

## ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University All rights reserved